

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Photodiode Segmentée en InGaAs à Quatre Zones Actives, 3 mm de dia.



#17-078, 3mm Dia., Four-Element Segmented InGaAs Photodiode

Stock **#17-078** [CONTACT](#)

-

1

+

 €615⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€615,00 prix unitaire
Qté 5-9	€545,00 prix unitaire
Qté 10-24	€507,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Temps de Montée/Descente @ VR=5V (ns):
24 (typical)

Propriétés physiques et mécaniques

Aire Actif (mm):
3 Dia.

Espace de l'Élément (mm):

0.045	
Electrical	
Réponse @ 1310nm (AW): 0.85 minimum / 0.9 typical	
Réponse @ 1550nm (AW): 0.9 minimum / 0.95 typical	
Capacitance @ V_R=5V (pF): 225	
Puissance de Bruit Équivalent NEP (W/ Hz^{1/2}): 2.50 x 10⁻¹⁴ @ 1550nm	
Tension Max. Inversée (V): 10	
Courant d'Obscurité @ V_R=5V (nA): Maximum: 100 Typical: 2.0	
Connectivité matérielle & interfaçage	
Connecteur: TO-8	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C): -40 to +75	
Température de Stockage (°C): -55 to +125	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance: Visionner	

Description produit

- Quatre zones actives distinctes
- Grande uniformité de réponse et faible diaphonie
- Idéales pour la détection de position et l'alignement de faisceaux
- [Photodiodes Segmentées au Silicium](#) et [Photodiodes en InGaAs](#) également disponibles

Les Photodiodes Segmentées en InGaAs présentent de grandes zones actives divisées en quatre éléments individuels. Les quatre éléments de ces photodiodes ont une grande uniformité de réponse et une faible diaphonie, ce qui permet de les utiliser dans des applications précises de correction de position ou de centrage. Ces photodiodes sont stables dans le temps et en température, offrant une réactivité de 900 à 1700 nm avec une excellente réactivité entre 1100 et 1620 nm. Les photodiodes InGaAs segmentées sont idéales pour les applications de détection de position, d'alignement de faisceau et de profilage de faisceau dans le spectre du proche infrarouge. Chaque photodiode est conditionnée dans un boîtier isolé TO-5 ou TO-8 avec une fenêtre traitée antireflet pour augmenter la transmission.

Informations techniques

